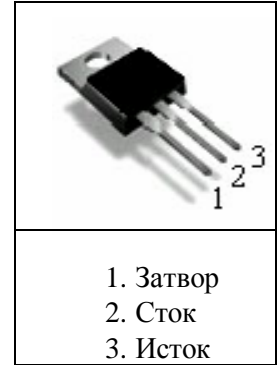


**КП796А,Б,В**

**МОЩНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ P-КАНАЛЬНЫЙ МОП ТРАНЗИСТОР**

АДБК 432140.950 ТУ

- \* Зарубежный аналог – **IRF9634**
- \* Изготавливается в корпусе КТ-28 (ТО-220).



**ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

| Параметры               | Обозначение | Един.<br>измер. | Предельные значения |      |      |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------|------|
|                         |             |                 | А                   | Б    | В    |
| Напряжение сток-исток   | Uси max     | В               | -250                | -300 | -200 |
| Напряжение затвор-исток | Uзи max     | В               | ±20                 | ±20  | ±20  |
| Постоянный ток стока    | Iс max      | А               | -4.1                | -3,7 | -4,1 |
| Импульсный ток стока    | Iс и max    | А               | -16                 | -15  | -16  |
| Рассеиваемая мощность   | Pmax        | Вт              | 74                  | 74   | 74   |
| Прямой ток диода        | Iпр. max    | А               | -4.1                | -3,7 | -4,1 |
| Температура перехода    | Tпер        | °С              | 150                 | 150  | 150  |

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Токр.ср.=25°С)**

| Параметры                                     | Обозначение  | Ед. измерения | Режимы измерения   | Min        | Max               |
|---|--------------|---------------|--|------------|-------------------|
| Пороговое напряжение                          | Uзи пор      | В             | Iс=-250мкА, Uзи=Uси  | -2.0       | -4.0              |
| Сопrotивление сток-исток в открытом состоянии | Rси отк      | Ом            | tи ≤300мкс. Q ≥50<br>Iс=-2.5А, Uзи=-10В                                  |            | 1,0<br>1,4        |
| Остаточный ток стока                          | Iс ост       | мкА           | Uси=-250В, Uзи=0<br>Uси=-300В, Uзи=0<br>Uси=-200В, Uзи=0                 | -          | -25<br>-25<br>-25 |
| Ток утечки затвора                            | Iз ут        | нА            | Uзи=±20В, Uси=0  | -          | 100               |
| Крутизна ВАХ                                  | S            | А/В           | tи ≤300мкс. Q ≥50<br>Uси=-20В, Iс=-4.1А<br>Uси=-30В, Iс=-3.7А            | 2,2<br>2,2 |                   |
| Прямое напряжение диода                       | Uпр          | В             | tи ≤300мкс. Q ≥50<br>Iс=-4.1А, Uзи=0<br>Iс=-3.7А                         |            | -6.5<br>-6,5      |
| Время задержки включения/выключения           | tзд.вкл/выкл | нс            | tи ≤300мкс. Q ≥50<br>Iс=-4.1А, Uси=-130В<br>Rс=31Ом, Rг=12Ом<br>Iс=-3.7А |            | 12/34             |
| Тепловое сопротивление переход-корпус         | Rt п-к       | °С/Вт         |  |            | 1.7               |
| Входная емкость                               | * C11и       | пФ            | Uзи=0, Uси=-25В,<br>f=1МГц   | -          | 1000              |
| Выходная емкость                              | * C22и       | пФ            | Uзи=0, Uси=-25В,<br>f=1МГц   | -          | 250               |
| Проходная емкость                             | * C12и       | пФ            | Uзи=0, Uси=-25В,<br>f=1МГц   | -          | 60                |

- Справочные параметры

220108, г.Минск, ул. Корженевского,16 УП "Завод Транзистор"

Отдел маркетинга: т/ф (10-37517) 212-59-32

E-mail: [market@transistor.com.by](mailto:market@transistor.com.by); [www.transistor.by](http://www.transistor.by)